

請求の範囲

- [請求項1] シリコンウェーハのD I C欠陥の形状測定方法であって、
パーティクルカウンターを用いて、前記シリコンウェーハの主面におけるD I C欠陥を検出する工程と、
前記検出したD I C欠陥の位置座標を特定する工程と、
前記特定した位置座標を用いて、位相シフト干渉法により、前記検出したD I C欠陥の少なくとも高さ又は深さを含む形状を測定する工程とを有することを特徴とするD I C欠陥の形状測定方法。
- [請求項2] 前記シリコンウェーハの主面がデバイス作製面であることを特徴とする請求項1に記載のD I C欠陥の形状測定方法。
- [請求項3] 請求項1又は2に記載のD I C欠陥の形状測定方法により測定した前記D I C欠陥の形状に基づいて研磨取り代を設定し、前記シリコンウェーハの研磨を行うことを特徴とするシリコンウェーハの研磨方法。
- 。